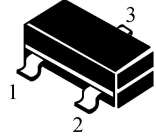




2SB1197K

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base voltage 集電極-基極電壓	$V_{\text{CBO}}$	-40	Vdc
-Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	$V_{\text{CEO}}$	-32	Vdc
Emitter-Base voltage 發射極-基極電壓	$V_{\text{EBO}}$	-5.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	$I_{\text{c}}$	-800	mAdc
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	$P_{\text{c}}$	225	mW
Junction Temperature 結溫	$T_{\text{j}}$	150	$^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature Range 儲存溫度	$T_{\text{stg}}$	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

■ DEVICE MARKING 打標

2SB1197K	Q	R
MARK	AHQ	AHR
$H_{\text{FE}}$	120~270	180~390



2SB1197K

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為  $25^{\circ}\text{C}$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min. 最小值	Typ. 典型值	Max. 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-20\text{V}$	—	—	-0.5	$\mu\text{A}$
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-4\text{V}$	—	—	-0.5	$\mu\text{A}$
Collect-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=-50\mu\text{A}$	-40	—	—	V
Collect-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-1\text{mA}$	-32	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-50\mu\text{A}$	-5	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	$h_{FE}$	$V_{CE}=-3\text{V},$ $I_C=-100\text{mA}$	120	—	390	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA},$ $I_B=-50\text{mA}$	—	—	-0.5	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極飽和壓降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA},$ $I_B=-50\text{mA}$	—	—	-1.2	V
Output Capacitance 輸出電容	$C_{ob}$	$V_{CB}=-10.0\text{V}, I_E=0,$ $f=1.0\text{MHz}$	—	12	30	pF
Transition Frequency 特徵頻率	$f_T$	$V_{CE}=-5\text{V},$ $I_C=-50\text{mA}$	—	200	—	MHz